

(独)日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会  
第111回研究会

日時： 2007年9月25日(火) 10:10~16:30

会場： 明治大学 駿河台キャンパス リバティタワー1166室(11階)

[http://www.meiji.ac.jp/koho/campus\\_guide/suruga/access.html](http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html)

懇親会(リバティタワー23階 サロン紫紺) 17:00~19:00 会費 3000円

テーマ「シリコン結晶中の点欠陥と不純物」

世話人:末岡 浩治(岡山県立大学), 井上 直久(大阪府立大学)

プログラム (変更の場合あり)

10:10~10:15 あいさつ

梅野正隆(福井工大)

10:15~10:45 積層欠陥成長からみたシリコンの拡散研究

和田一実(東京大学)

10:45~11:15 同位体シリコンを用いたシリコンの拡散研究

松本智(慶応大学)

11:15~11:45 シリコン結晶成長中の点欠陥挙動に関する数値シミュレーション

中村浩三(SUMCO TECHXIV)

11:45~12:15 シリコン結晶中の点欠陥に関する理論研究

末岡浩治(岡山県立大学)

12:15~13:30 昼食休憩

13:30~14:00 超音波による原子空孔の測定

金田寛(新潟大学)

14:00~14:30 シリコン結晶中の原子空孔の挙動 -水素を利用したシリコン結晶中の点欠陥研究-

末澤正志(東北大学)

14:30~15:00 休憩

15:00~15:30 照射シリコン単結晶の点欠陥とその応用の赤外吸収法による研究

井上直久(大阪府立大学), 杉山隆英(豊田中央研究所)

後藤安則(トヨタ自動車), 大山英典(熊本電波高専)

15:30~16:00 高濃度 B および As ドープシリコン結晶における酸素析出核の形成挙動

杉村渉, 小野敏昭, 宝来正隆(SUMCO)

16:00~16:30 高密度化の鍵を握るウェーハ薄化技術

小林義和(株式会社ディスコ)

17:00~19:00 懇親会

以上